



主催：数電機連携プログラム推進室

数理科学的発想と工学的発想を兼ね備えた

# 第6回 数電機キャリアパスセミナー

開催日： 2010年2月10日（水曜日）

開催時間： 16:30-17:50

（17:50-18:30 懇談会・討論会）

開催場所：首都大学東京12号館106教室

講師：菅原 良孝 氏

（SiCパワーエレクトロニクスネットワーク 代表  
（元 関西電力 エグゼクティブ・リサーチャー））

講演題目：「電力用次世代SiCパワー半導体素子開発  
における数学活用事例」

## 講演概要

現在のSi半導体素子に代わる次世代素子としてSiC半導体素子が注目されている。すでに、Siに比べて10から100倍の電力損失低減効果があることが実証されており、今後の省エネルギーのキー技術の一つとして注目され、現在3件の国プロも進行しつつある。講演者は、このSiC素子とその応用装置開発に20年弱関わってきており、その開発過程で数値解析の恩恵を多々受けてきており、その一端を御紹介する。併せて、御理解を深めていただくために、SiCパワー素子とその開発概況についても御紹介する。

主催：数電機連携プログラム推進室

（首都大学東京・理工学研究科、

数理情報科学専攻・電気電子工学専攻・機械工学専攻）

192-0397 東京都八王子市南大沢 1-1

問い合わせ先：数電機連携プログラム推進室

Tel:042 (677) 2466 内線(3158) （担当：酒井） E-mail: sakai-t@tmu.ac.jp